

Ptfe-Runder Waferträger 6 Zoll Säure- Und Laugenbeständig Halbleiter-Reinigungskorb Anpassbar

Artikelnummer: PL-CP207



Einführung

Hochreine 6-Zoll-PTFE-Rundwaferträger, entwickelt für die Halbleiterreinigung. Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen Säuren und Laugen für Piranha- und HF-Ätzprozesse. Präzisionsgefertigte, vollständig anpassbare Körbe gewährleisten die sichere Handhabung von Substraten bei anspruchsvollen nasschemischen Prozessen, Tauchbädern und Ultraschallspülungen.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
RCA-Reinigungsprozess	Verwendet zum Entfernen organischer Rückstände, dünner Oxidschichten und ionischer Verunreinigungen von Siliziumwafern unter Verwendung von SC-1- und SC-2-Lösungen.	Hohe thermische und chemische Beständigkeit verhindert die Degradation des Trägers während des Eintauchens in beheizte Bäder.
Piranha-Ätzung	Handhabung von Wafern in einer Mischung aus Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid zum Entfernen schwerer organischer Materie.	Außergewöhnliche Beständigkeit gegen aggressive oxidative Umgebungen sorgt für eine lange Lebensdauer der Ausrüstung.
Flusssäure-(HF)-Tauchbäder	Entfernung von Opferoxidschichten oder nativen Oxiden von Siliziumoberflächen in verschiedenen Konzentrationen von HF.	Materialreinheit verhindert das Einbringen von metallischen Ionen in die empfindliche Ätzumgebung.
Spülung nach CMP	Transport von Wafern durch Reinigungszyklen nach dem chemisch-mechanischen Polieren (CMP), um Schlickerpartikel zu entfernen.	Glatte, nicht haftende Oberflächen verhindern den Einschluss von Partikeln und erleichtern eine effektive Ultraschallreinigung.
Solarzellenfertigung	Verarbeitung von 6-Zoll-Monokristallin- oder polykristallinen Siliziumwafern während der Texturierungs- und Phosphordiffusionsschritte.	Robuste Bauweise unterstützt hohen Durchsatz in anspruchsvollen industriellen Produktionslinien.
Fotolithografie	Unterstützung von Substraten während der Entwicklung und des Strippen von Fotolack unter Verwendung von Lösungsmitteln und spezialisierten Strippern.	Universelle Lösungsmittelkompatibilität verhindert Quellen oder Erweichen des Trägerrahmens.
Ultraschallreinigung	Transport empfindlicher Komponenten in Ultraschall- oder Megasonic-Bädern zur hochpräzisen Entfernung von Verunreinigungen.	Strukturelle Steifigkeit ermöglicht eine effiziente Übertragung von Schallenergie auf die Waferoberflächen.
Ätzung von Verbindungshalbleitern	Verarbeitung von GaAs-, InP- oder SiC-Wafern in spezialisierten chemischen Mischungen für die Fertigung optoelektronischer Bauelemente.	Anpassbare Schlitzgeometrie accommodiert verschiedene Waferdicken und empfindliche Substratmaterialien.

Parameter	Spezifikationsdetails für PL-CP207
Modellkennung	PL-CP207
Materialkonstruktion	Hochreines unvermisches PTFE (Benutzerdefinierte PFA-Optionen verfügbar)
Wafergrößenkompatibilität	6 Zoll / 150 mm Durchmesser
Geometrieconfiguration	Runder Reinigungskorb / Blumenkorb-Typ
Chemische Kompatibilität	Universelle Beständigkeit (Säuren, Basen, Lösungsmittel, Oxidationsmittel)
Temperaturtoleranz	Geeignet für kryogene bis hochtemperierte Prozesse

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Parameter	Spezifikationsdetails für PL-CP207	
Anpassungsfähigkeit	Vollständig anpassbare Abmessungen, Schliitzanzahlen und Griffkonfigurationen	
Oberflächenfinish	Präzisionsbearbeitet, ultra-glatt, nicht porös	
Chargenkapazität	Maßgefertigt nach spezifischen Kundenanforderungen für Waferanzahl	
Herstellungsmethode	Maßgeschneiderte CNC-Bearbeitung / Benutzerdefinierte Fertigung	